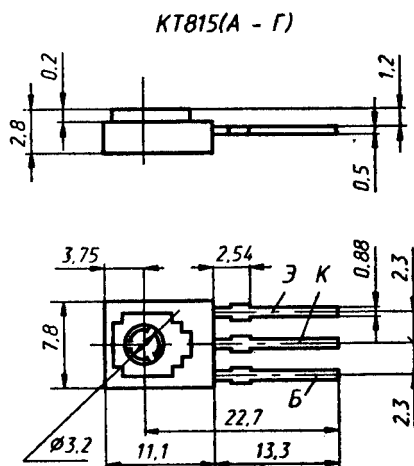


КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г

Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, завод «Искра», г. Ульяновск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 2$ В, $I_k = 0,15$ А, не менее:

$T = +25$ °С:	
КТ815А, КТ815Б, КТ815В	40
КТ815Г	30
$T = -40$ °С:	
КТ815А, КТ815Б, КТ815В	30
КТ815Г	20

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5$ В, $I_3 = 0,03$ А, не менее

Граничное напряжение при $I_3 = 50$ мА, $t_{и} = 300$ мкс, $Q \geq 100$, не менее:

КТ815А	25 В
КТ815Б	40 В
КТ815В	60 В
КТ815Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 0,5$ А, $I_б = 0,05$ А, не более

при $I_k = 0,5$ А, $I_б = 0,05$ А, не более

типичное значение

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 0,5$ А, $I_б = 0,05$ А, не более

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 40$ В,
не более:

$T_k = -40...+25$ °С	50 мкА
$T = +100$ °С	1000 мкА

Входное сопротивление в режиме малого сигнала при $U_{кз} = 5$ В, $I_k = 5$ мА, $f = 800$ Гц, не менее 800 Ом
Емкость коллекторного перехода при $U_{кз} = 5$ В, $f = 465$ кГц, не более 60 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5$ В, не более 75 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

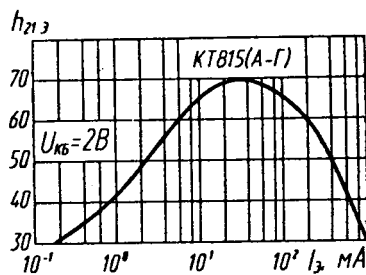
$R_{эз} \leq 100$ Ом:	
КТ815А	40 В
КТ815Б	50 В
КТ815В	70 В
КТ815Г	100 В
$R_{эз} = \infty$:	
КТ815А	25 В
КТ815Б	40 В
КТ815В	60 В
КТ815Г	80 В

Постоянное напряжение база—эмиттер 5 В
Постоянный ток коллектора 1,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} < 10$ мс, $Q \geq 100$ 3 А
Постоянный ток базы 0,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T = -40...+25$ °С:
с теплоотводом 10 Вт
без теплоотвода 1 Вт
Температура р-п перехода +125 °С
Температура окружающей среды -40... $T_k = +100$ °С

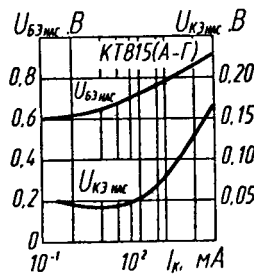
¹ $P_{к макс}$ снижается линейно на 0,1 Вт/°С с теплоотводом и на 0,01 Вт/°С без теплоотвода.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм; при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса путем погружения выводов не более чем на 2 с в расплавленный припой с температурой не выше +250 °С.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора